

# ОПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В КРИСТАЛЛАХ $\{N(CH_3)_4\}_2MnCl_4$

*О. Г. Влох, Б. В. Каминский, И. И. Половинко, С. А. Свелеба*

Кристаллы тетрахлорманганата тетраметиламмония  $\{N(CH_3)_4\}_2MnCl_4$  (TMA—Mn) принадлежат к активно исследуемой группе  $\{N(CH_3)_4\}_2XCl_4$  ( $X=Zn, Co, Cu, Fe, Mn$ ). Их особенностью является большое число фазовых переходов, включая переходы в несоразмерную (Н), сегнетоэлектрическую и сегнетоэластическую (С) фазы [1]. Кристаллы TMA—Mn пре-

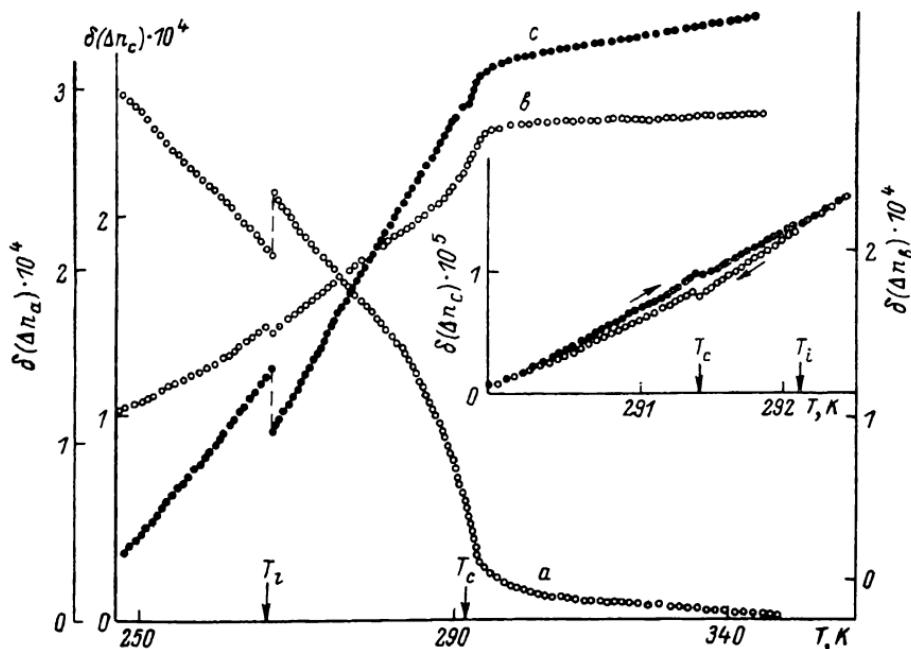


Рис. 1. Температурные зависимости двупреломления  $\delta(\Delta n)$  для главных срезов кристаллов TMA—Mn.

На вставке — температурный гистерезис  $\delta(\Delta n_c)$  в окрестности Н фазы.

терпевают переходы из исходной фазы с симметрией  $Pmc$  при  $T_i = -292.1$  К в Н-фазу и далее при  $T_c = 291.5$  К в С-фазу (С1) с удвоением элементарной ячейки и симметрией  $P2_1/c11$  и при  $T_i = 266.5$  К в С-фазу (С2) с утройством элементарной ячейки и симметрией  $P112_1/n$  [2]. От других кристаллов указанного семейства они, кроме прочего, отличаются очень малой шириной Н фазы.

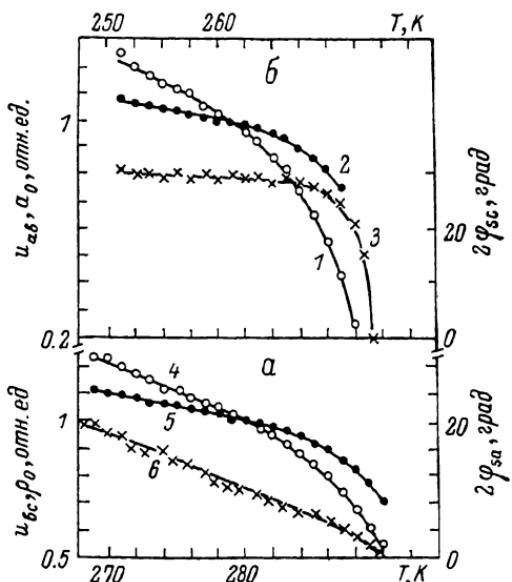
Кристаллы TMA—Mn выращивались из водного раствора солей  $\{N(CH_3)_4\}Cl$  и  $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ , взятых в стехиометрическом отношении, методом медленного испарения при  $T = 303$  К. Исследования проводились путем измерения оптического двупреломления  $\delta(\Delta n)$  методом Сенармона с применением магнитооптического модулятора и синхронного детектора с точностью  $10^{-8}$  на  $\lambda = 633$  нм. Спонтанные повороты оптической индикаторы  $\varphi$ , измерялись по углу погасания доменов на поляризационном микроскопе МИН-8 с низкотемпературной приставкой с точностью 0.5 угл. град. Температура измерялась с точностью 0.01 К. Установка образцов в кристаллографической системе координат осуществлялась согласно [2].

На рис. 1 представлены температурные зависимости  $\delta(\Delta n)$  для главных срезов кристалла TMA—Mn, измеренные в режиме охлаждения

со скоростью 0.1 К/мин. Значительные скачки  $\delta$  ( $\Delta n$ ) величиной  $\sim 3 \cdot 10^{-5}$  наблюдаются для  $a$ - и  $c$ -срезов в области низкотемпературного перехода  $T_i$ , разделяющего соседние С фазы. Характерный для Н кристаллов аномальный температурный гистерезис имеет место во всей Н фазе и в прилегающей к ней части С фазы (вставка рис. 1). В исходной фазе  $\delta$  ( $\Delta n$ ) линейно изменяется с температурой, а наблюдаемые небольшие отклонения от линейности в области  $T - T_i = 0.15$  К связаны, по-видимому, с флуктуациями параметра порядка [3]. При  $T_i$  в температурном поведении  $\delta$  ( $\Delta n$ ) наблюдаются изломы, а при  $T_c$  — размытые скачки величиной  $\sim 1.5 \cdot 10^{-6}$ . Фазовые переходы можно таким образом отнести к следующим типам: при  $T_i$  — 2-го рода, при  $T_c$  — 1-го рода, близкий ко 2-у, при  $T_i$  — 1-го рода.

Последовательные фазовые переходы в кристаллах ТМА—Мн

Рис. 2. Зависимости спонтанных деформаций  $u_{bc}(4)$ ,  $u_{ab}(1)$ , параметров порядка  $\rho_0(5)$ ,  $a_0(2)$  и углов спонтанного поворота индикатрисы  $\varphi_{sa}(6)$ ,  $\varphi_{sc}(3)$  от температуры в сегнетоэластических фазах кристаллов ТМА—Мн.



можно описать, используя форму термодинамического потенциала, приведенную в [4], с учетом дополнительных членов, указанных в [2],

$$\Phi = \frac{\alpha}{2} Q_k Q_k^* + \frac{\beta}{4} (Q_k Q_k^*)^2 + \frac{\gamma}{6} (Q_k Q_k^*)^3 + \frac{\nu}{8} (Q_k Q_k^*)^4 + \frac{\pi}{10} (Q_k Q_k^*)^5 + \\ + \frac{\pi}{20} (Q_k^{10} + Q_k^{*10}) + i\xi_2 u_{ab} (Q_{1/2}^3 - Q_{1/2}^{*3}) - i\xi_1 u_{bc} (Q_{1/2}^2 - Q_{1/2}^{*2}) + \\ + \frac{\delta i}{2} \left( Q_k^* \frac{dQ_k}{dx} - Q_k \frac{dQ_k^*}{dx} \right) + \frac{k}{2} \frac{dQ_k^*}{dx} \frac{dQ_k}{dx} + \frac{c_{66}}{2} u_{ab}^2 + \frac{c_{44}}{2} u_{bc}^2. \quad (1)$$

Здесь учтены только члены, содержащие параметр порядка  $Q$  и сдвиговые деформации  $u_{bc}$  и  $u_{ab}$ . Полагая  $Q_k = \rho e^{i\theta}$  и следуя выводам термодинамической теории [5, 6], получим, что спонтанное двупреломление  $\delta_s$  ( $\Delta n$ ) в Н фазе пропорционально квадрату амплитуды параметра порядка  $\rho$ . Вычитая из зависимости  $\delta_s$  ( $\Delta n_s$ ) =  $f(T)$  термооптический вклад линейной экстраполяцией из исходной фазы и строя полученные значения  $\delta_s$  ( $\Delta n_s$ ) в функции от  $(T_i - T)$  в двойном логарифмическом масштабе, можно найти критический индекс  $\beta$  для переходов 2-го рода:  $\delta_s$  ( $\Delta n$ )  $\sim (T_i - T)^{2\beta}$ . В области  $0.2 \text{ K} < T_i - T < 0.6 \text{ K}$  указанная зависимость линейна, что дает значение  $2\beta = 0.34 \pm 0.01$  и хорошо согласуется с результатами рентгеновских исследований ( $2\beta = 0.35$  [2]). Значительное отличие найденного значения  $2\beta$  от классической величины для теории Ландау ( $2\beta = 1$ ) носит скорее всего флуктуационный характер.

Минимизация (1), рассматриваемого в полярных координатах, по  $u_{bc}$  для фазы С1 ( $Q_{1/2} = \rho_0$ ,  $\cos 2\theta = 0$ ,  $dQ_k/dx = 0$  [7]) и по  $u_{ab}$  для фазы С2 ( $Q_{1/2} = a_0$ ,  $\cos 3\theta = 0$ ,  $dQ_k/dx = 0$ ) дает следующие решения

$$u_{bc} = \frac{2\xi_1 \rho_0^2}{c_{44}}, \quad u_{ab} = \frac{2\xi_2 a_0^3}{c_{66}}. \quad (2)$$

Исходя из симметрийных соображений [8, 9] в фазах С1 и С2  $\delta_s$  ( $\Delta n_i$ ) ( $i=1, 2, 3$ ) выражаются соответственно как

$$\delta_s (\Delta n_i) \sim u_{bc}^2 \sim p_0^4, \quad (3)$$

$$\delta_s (\Delta n_i) \sim u_{ab}^2 \sim a_0^6. \quad (4)$$

Поскольку фазовые переходы при  $T_c$  и  $T_t$  являются несобственными сегнетоэластическими, спонтанные деформации служат макроскопическими вторичными параметрами порядка и, следуя [9], с учетом симметрии переходов должны быть пропорциональны углу спонтанного поворота оптической индикатрисы. В данном случае измерения  $\delta_s (\Delta n)$  следует проводить вдоль оси моноклинности, которой служит в фазе С1 ось  $a$ , а в фазе С2 — ось  $c$ .

На рис. 2 показаны температурные зависимости  $u_{bc} \sim \sqrt{\delta_s (\Delta n)}$ ,  $p_0^4 \sim \sqrt{\delta_s (\Delta n_a)}$ , нормализованные для 280 К (рис. 2, а) и  $u_{ab} \sim \sqrt{\delta_s (\Delta n_c)}$ ,  $a_0 \sim \sqrt[8]{\delta_s (\Delta n_a)}$ , нормализованные для 257 К (рис. 2, б). Там же приведены зависимости  $\varphi_{sa}=f(T)$  для фазы С1 и  $\varphi_{sc}=f(T)$  для фазы С2. Характер поведения  $\varphi_{sa}$  и  $u_{bc}$  в фазе С1 одинаков. Это говорит о том, что спонтанный поворот индикатрисы обусловлен параметром порядка через спонтанный упругооптический эффект. Различный характер зависимостей  $\varphi_{sc}$  и  $u_{ab}$  для фазы С2 говорит о значительном прямом вкладе параметра порядка в  $\varphi_{sc}$ .

Таким образом, проведенные исследования позволили установить характер поведения параметров порядка в несоразмерной и соразмерных сегнетоэластических фазах кристалла ТМА—Mn.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Yamada Y., Hamaya N. J. Phys. Soc. Japan, 1983, vol. 52, N 10, p. 3466—3474.
- [2] Mashiyama H., Tanisaki S. J. Phys. Soc. Japan, 1981, vol. 50, N 5, p. 1413—1414.
- [3] Regis M., Ribet I. L., Jamet I. P. J. Phys. Lett., 1982, vol. 43, N 10, p. L333—L338.
- [4] Mashiyama H. J. Phys. Soc. Japan, 1980, vol. 49, N 6, p. 2270—2277.
- [5] Санников Д. Г., Леваник А. П. ФТТ, 1978, т. 20, № 4, с. 1005—1012.
- [6] Kojak C. Phys. St. Sol. (a), 1979, vol. 54, N 7, p. 99—102.
- [7] Ishibashi Y. In: Incommensurate phases in dielectrics Materials / Ed. by R. Blinc, A. P. Levanyuk. Amsterdam : North-Holland, 1980, p. 51—69.
- [8] Иванов Н. Р. Изв. АН ССР, сер. физ., 1983, т. 47, № 3, с. 450—464.
- [9] Gomez-Cuevas A., Tello M. J., Fernandez J., Lopez-Echarri A., Herreros J., Cousi M. J. Phys. C: Sol. St. Phys., 1983, vol. 16, N 4, p. 473—485.

Львовский государственный университет  
им. И. Франко  
Львов

Поступило в Редакцию  
5 мая 1987 г.  
В окончательной редакции  
17 июля 1987 г.

УДК 535.343.2; 535.37

Физика твердого тела, том 30, в. 1, 1988  
Solid State Physics, vol. 30, № 1, 1988

#### ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ В СПЕКТРЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ CdS

P. B. Григорьев, И. Комтхаяс,<sup>1</sup> И. П. Калмыкова,  
Б. В. Новиков, К. Сикорский<sup>1</sup>

Процессы локализации экситонов и свободных носителей в приповерхностной области вызывают в последнее время большой интерес исследователей [1, 2]. В частности, достаточно подробно исследованы процессы ло-

<sup>1</sup> Институт прикладной физики, Гамбургский университет, ФРГ.